文章编号:1007-4252(2006)04-0299-04

# 基于非线性介电薄膜的电调滤波器优化设计

吴达军,何世明,刘兴钊,李言荣

(电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,成都 610054)

摘要:采用脉冲激光沉积(PLD)法在(001)MgO 基片上制备出高质量的 SrTiO<sub>3</sub>(STO)薄膜,构建了 Au/STO/MgO 结构的叉指电容。在 77K、10KHz 条件下,对叉指电容的特性进行了测试,结果表明:在40 kV/cm 的直流电场作用下,电容值从1.75 pF 减小为1.25 pF,电容值的相对变化率为28. 5%。在此基础上,根据多层介质叉指电容保角变换模型。定量计算和仿真了 STO 薄膜的介电常 数和微波频率下叉指电容的性能参数,并由此设计了一个三阶带通滤波器,该滤波器可实现 13.50% 的中心频率移动。

**关键词**:STO;薄膜;介电性质;叉指电容;滤波器 中图分类号:O484 **文献标识码**:A

#### Optimized design of electrically tunable filter based on nonlinear dielectric film

WU Da-jun, HE Shi-ming, LIU Xing-zhao, LI Yan-rong

(National Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices,

University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China)

Abstract: Excellent (001)  $\text{SrTiO}_3(\text{STO})$  thin films were grown on (001) MgO substrates by pulsed laser deposition (PLD) method. Interdigital capacitors (IDC) were fabricated on the STO films. When the electric field increases from 0 kV/cm to 40 kV/cm, the capacitance drops from 1.75 pF to 1.25 pF at 77K and 10kHz. The permittivity  $\varepsilon_r$  of STO films were calculated by the conformal mapping – based models. A three – pole bandpass filter based on the IDC was designed. Excellent performances of the filter are achieved.

Key words: STO; thin film; dielectric properties; IDC; filter

1 引言

SrTiO<sub>3</sub>(STO)是一种具有优良非线性介电特性 的钙钛矿型铁电氧化物材料。由于它在压控振荡器 (VCO)、电调滤波器、移相器和调谐匹配网络等微 波频移器件中具有巨大的应用前景,已成为当前电 子薄膜与集成器件科学研究的热点之一。近几年 来,国外研究机构采用溅射(Sputtering)、脉冲激光 沉积(PLD)和化学气相沉积(CVD)等不同的制膜 方法,在多种基片上研制基于 STO 薄膜的电调滤波

收稿日期:2005-08-16; 修订日期:2005-11-07

基金项目:四川省青年基金资助课题.

作者简介:吴达军(1974 - ),男,德阳人,博士生,从事电子材料薄膜及器件的研究(E-mail: zjncnyj@163.com).

器<sup>[1-3]</sup>,但普遍存在调谐范围小(<10%),插入损 耗大(>5dB),中心频率移动过程中带宽保持性差 等问题。鉴于此,本工作在制备出高质量 STO 介电 薄膜的基础上,采用终端加载铁电叉指电容式滤波 器结构,设计得到了低插损、高可调、带宽保持性良 好的三级带通滤波器。

#### 2 实验

STO 薄膜的生长采用脉冲激光沉积(PLD)方 法,选用(001) MgO 单晶基片,以 SrTiO<sub>3</sub> 单晶为靶 材, COMPEX – 201 型 KrF 准分子激光器为光源( $\lambda$ = 248 nm)。在 STO 外延薄膜的生长过程中,以纯 氧为工作气氛,氧压为10 Pa,基片温度为780 ℃,激 光脉冲能量密度为2 J/cm<sup>2</sup>,脉冲重复频率为6 Hz, 靶基距为45 mm。

STO 薄膜的结晶取向采用 X - Ray 衍射技术进行分析,STO 薄膜的表面形貌采用扫描探针显微镜 (SPM)进行表征。

采用电子束蒸发法在 STO 薄膜表面沉积约 1 μm 厚的 Au 膜,再经光刻形成叉指电容,用 Agilent HP4284A 型 LRC 测试仪及标准四端对测量法测试 叉指电容的性能。在整个测试过程中,叉指电容浸 没在液氮中以获得 77K 的低温环境。

根据叉指电容的测试数据,利用多层介质叉指 电容保角变换模型和 EDA 软件,定量计算了 STO 薄膜的介电常数及微波频率下叉指电容的性能参 数,并以此设计了一个基于 STO 非线性介电特性的 三级电调带通滤波器。

## 3 结果与讨论

实验对 STO/(001) MgO 薄膜的生长机理进行 了详细的系列研究,得到了 PLD 法制备高质量 STO/MgO 薄膜的优化工艺条件。所制备 STO/MgO 薄膜的典型 XRD 谱如图 1 所示,由图 1 可见:STO 薄膜具有垂直于基片表面的单一(001)取向。STO 薄膜的晶粒大小均匀、结构致密、表面平整(RMS = 5.922 nm),其 AFM 形貌图如图 2 所示。

将 STO 表面沉积的金膜采用光刻工艺刻蚀成 叉指电容,其具体参数为:  $N = 30,2s = 2g = g_{end} =$ 0.01 mm, L = 0.2mm,其中, N 为叉指数, 2s 为叉指 宽度, 2g 为叉指间距,  $g_{end}$  为单个叉指的终端缝隙, L



Fig. 1 XRD spectrum of STO thin film deposited on MgO substrate 图 1 STO 薄膜的 XRD 扫描图谱



Fig. 2 AFM image of STO thin film 图 2 STO 薄膜的 AFM 形貌图

为叉指长度,如图3所示。

在 77 K、10 kHz 测试条件下,叉指电容的电容 – 电压特性曲线(C - V)和介电损耗 – 电压关系曲 线( $\tan\delta - V$ )如图 4 所示。在外加电场为零时,电容 值和介电损耗分别为 1.75 pF 和 0.007,随着电场强 度的增加,电容和介电损耗都逐渐减小,当电场强度 增加到 40 kV/cm 时,电容值为 1.25 pF,介电损耗 减小为 0.0013。电容值的相对变化率(Tunability) = $\frac{C(0) - C(E_{max})}{C(0)}$ 为 28.5%。从图中可知,C - V曲 线和  $\tan\delta - V$ 曲线均保持良好的对称性,因此,在实 际电路中可以根据需要加正向偏压或反向偏压。

12 卷



Fig. 3 Model of interdigital capacitor(a) top - view (b) cross section





Fig. 4 Curves of capacitance and  $\tan \delta$  as functions of DC voltage for interdigital capacitor

图4 叉指电容的 C-V、tanδ-V关系曲线

在进行滤波器设计之前,采用多层介质叉指电容保角变换模型<sup>[4]</sup>计算了 STO 薄膜的介电常数,当 电容值为1.75 pF 和1.25 pF 时,介电常数分别为 279 和188。文献表明:当频率低于 8 GHz 时,STO 薄膜的介电常数没有明显的频散效应,即:介电常数 随频率的增加基本保持不变<sup>[5-7]</sup>。于是,使用 EDA 软件。建立叉指电容计算机模型,并抽取出了频率 为1.25 GHz、介电常数为 279 和188 时叉指电容器 的电容值,分别为1.74 pF 和1.26 pF,与10 kHz 的 测试值相比,偏差小于 1%,这一结果与 A. B. Kozyrev 对 STO 电容在低频和微波频率下的研究结 论相符<sup>[8]</sup>。因此,利用多层介质叉指电容保角变换 模型进行计算与仿真,可以比较准确地得到 STO 薄 膜的介电常数,从而为电调带通滤波器的设计奠定 了基础。

## 4 电调带通滤波器的设计与优化

根据上面叉指电容的计算结果,选用阻带特性 好、结构紧凑、体积小的切比雪夫型梳状线带通滤波 器进行设计<sup>[9]</sup>,如图 5 所示。其中,C<sub>1</sub><sup>s</sup>、C<sub>2</sub><sup>s</sup>、C<sub>3</sub><sup>s</sup>是 基于 STO 薄膜的集总参数叉指电容器。

滤波器的设计参数为:中心频率为 $f_0$ ,相对带宽 FBW = 4%,带内插入损耗 *IL* < 1.5 dB,带内波纹系 数 Ripple = 0.1dB,带外抑制 *RJ* > 40dB(在 $f_0 \pm 100$ MHz 处)。

先从理论上对滤波器的物理结构尺寸进行计 算,根据计算结果采用 EDA 软件进行滤波器的建 模、仿真和优化,得到一组优化值。表1列出了设计 的三级梳状线带通滤波器电路参数理论值与优化 值。

Toble 1 Comparison of the calculated and optimized values of the electrical parameters and physical sizes of the filter 表 1 滤波器电路参数的理论值与优化值对比

传输线 j	J变换器导纳归一化互电容		线间距 S <sub>j,j+1</sub> /mm		11:12:42:	归一化自电容	线宽 ₩ <sub>j</sub> /mm	
	$J_{j,j+1}/Y_{A}$	$C_{j,j+1}/\varepsilon$	计算值	优化值	乍棚线」	$C_{\rm j}/\varepsilon$	计算值	优化值
0,3		1.384	3.840	3.4744	0,4	6.150	10.840	7.8040
1,2	0.04	0.241	11.840	13.2160	1,3	3.730	6.496	5.3481
					2	4.618	7.354	5.7560
n = 3 时,切比雪夫响应低通原型值为:g <sub>0</sub> = g <sub>4</sub> = 1.0000, g <sub>1</sub> = g <sub>3</sub> = 1.0315, g <sub>2</sub> = 1.1474								







Fig. 6 Simulated results  $(S_{11}, S_{21})$  of the 3 – pole combline bandpass filter

图6 三阶梳状线带通滤波器仿真结果

在加上不同的直流偏压时,叉指电容器的电容 值将发生改变,单个谐振器的谐振频率也随之改变, 滤波器的中心频率相应地发生移动,从而实现滤波 器的电调,滤波器的仿真结果如图 6 所示。当叉指 电容的容值由 1.72 pF 减小到 1.26 pF 时,滤波器的 中心频率从  $f_1$  移动到  $f_2$ ,中心频率改变量  $\Delta f$  为 180 MHz,频率相对调谐率为 13.50%。而且,在整个频 率移动过程中,带内插入损耗始终小于设计值 1.5 dB,回波损耗  $IS_{11}$  + 大于 12 dB,相对带宽仅从设计值 4% 变化为 4.17%,带外抑制 RJ > 41 dB(在  $f_0$  ± 100 MHz 处),所有指标均满足设计要求,保持了良 好的滤波特性。

### 5 结论

采用脉冲激光沉积法制备出了(001)取向、结构致密、表面平整的STO/MgO薄膜,在77k、10 kHz 条件下,对Au/STO/MgO结构的叉指电容器测试结 果表明:在外加40 kV/cm 直流电场作用时,获得 328.5%的电容相对变化率。根据多层介质叉指电 容保角变换模型,结合EDA软件,定量计算了STO 薄膜的介电常数,并通过仿真抽取了叉指电容在微 波频率下的性能参数,与测试结果相比,误差小于 1%。在此基础上设计了三阶带通滤波器,仿真结果 表明:该滤波器具有良好的特性,其中心频率的相对 频移达到了13.50%。

#### 参考文献:

- [1] Felix A Miranda, Guru Subramanyam, Frederick W Van Keuls, et al. Design and Development of Ferroelectric Tunable Microwave Components for Ku – and K – Band Satellite Communication Systems [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2000,48:1181-1189.
- [2] Irina Vendik, Orest Vendik, Vladimir Pleskachev, et al. Tunable Microwave Filters Usinig Ferroelectric Materials
  [J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2003,13:716-719.
- [3] Vladimir Pleskachev, Irina Vendik. Figure of Merit of Tunable Ferroelectric Planar Filter [A]. 33rd European Microwave Conference – Munich[C]. 2003. 191 – 194.
- [4] Spartak S Gevorgian, Torsten Martinsson, Peter L J, et al. CAD models for multilayered substrate interdigital capacitors
  [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1996, 44:896 - 904.
- [5] Peter Kr Petrov, Erik F Carlsson. Improved SrTiO<sub>3</sub> multilayers for microwave application: growth and properties
  [J]. J Appl Phys, 1998,84:3134-3140.
- [6] Nobuyuki Sugii, Hiroji Yamada, Osamu Kagaya, et al. High – frequency properties of SrTiO<sub>3</sub> thin – film capacitors fabricated on polymer – coated alloy substrates [J]. J Appl Phys, 1998,72:261 – 263.
- [7] Kozyrev A B, Samoilova T B, Golovkov A A, et al. Nonlinear behavior of thin film SrTiO<sub>3</sub> capacitors at microwave frequencies [J]. J Appl Phys, 1998, 84:3326-3332.
- [8] Kozyrev A, Ivanov A, Keis V, et al. Ferroelectric films: nonlinear properties and applications in microwave devices
  [J]. IEEE MTT - S Digest, 1998; 985 - 988.
- [9]甘本祓, 吴万春. 现代微波滤波器的结构与设计 [M]. 北京:科学出版社, 1973. 191-197.

12 卷

# 微波滤波器设计培训——视频课程

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立,致力和专 注于微波、射频、天线设计研发人才的培养,是国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地。 客户遍布中兴通讯、研通高频、国人通信等多家国内知名公司,以及台湾工业技术研究院、永 业科技、全一电子等多家台湾地区企业。

我们推出的微波滤波器设计培训专题,有资深工程师领衔主讲,课程既有微波滤波器设计 原理的详细解释,也有各种仿真分析工具的实际设计应用讲解,设计原理和设计仿真实践相结 合,向大家呈现各种结构的微波滤波器的完整设计流程。旨在帮助大家透彻地理解并实际的掌 握各种微波滤波器的设计。



## 微波滤波器设计培训专题视频课程

高清视频,专家授课,中文讲解,直观易学;既有微波滤波器设计原理的详细解释,也有像 ADS、CST、HFSS 各种仿真分析工具的实际设计应用讲解,旨在帮助大家透彻地理解并实际的掌握各种微波滤波器的设计。

课程网址: http://www.edatop.com/peixun/filter/

## ▷ 更多专业培训课程:

● HFSS 视频培训课程

网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/

● CST 视频培训课程

网址: http://www.edatop.com/peixun/cst/

天线设计专业培训课程
网址: http://www.edatop.com/peixun/antenna/



专注于微波、射频、天线设计人才的培养 官方网址: http://www.edatop.com 淘宝网店: http://shop36920890.taobao.com